

N1.8I

硅 NPN 外延平面晶体管芯片 (4 ")

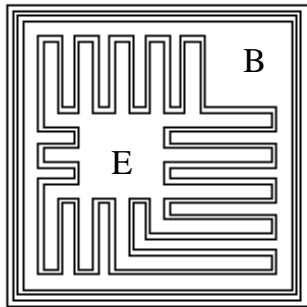
■用途:

- *电源调整管
- *音频功率放大器
- *其它电子电路

■特征:

- *功率耐量大
- * 有效图形数: 2230

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	1780 μ m × 1780 μ m
压焊区尺寸	基区 495 μ m × 495 μ m 发射区 495 μ m × 495 μ m
芯片厚度	240 ± 10 μ m
锯片槽宽度	80 μ m
金属层	正面: Al 3.1 ± 0.3 μ m 背面: Ag 1.4 ± 0.2 μ m

■电特性(Ta=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小值					最大值	单位
			A	B	C	D	E		
集电极-基极击穿电压	BV _{CBO}	I _C = 0.1 mA, I _E = 0	80	100	120	150	180		V
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _C =10 mA, I _B = 0	60	80	100	120	150		V
发射极-基极击穿电压	BV _{EBO}	I _B =0.1 mA, I _C = 0	6						V
集电极-基极截止电流	I _{CBO}	V _{CB} =0.8 BV _{CBO} , I _E = 0						1	μ A
发射极-基极截止电流	I _{EBO}	V _{EB} = 5V, I _C = 0						1	μ A
直流电流增益 (A、B、C)	h _{FE}	V _{CE} = 5V, I _C = 1A	60					250	
直流电流增益 (D、E)	h _{FE}	V _{CE} = 5V, I _C = 0.5A				60		250	
集电极-发射极饱和电压	V _{CES}	I _C = 4A, I _B =0.4A						1.5	V
基极-发射极饱和电压	V _{BES}	I _C = 4A, I _B =0.4A						2	V